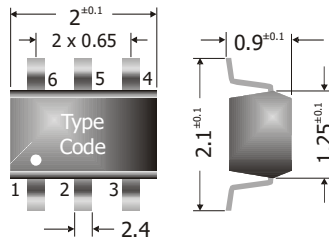


BAS16DW, BAV70DW, MMBD4448SDW
SMD Small Signal Diode Arrays
SMD Kleinsignal-Dioden-Arrays
 $I_{FAV} = 150 \text{ mA}$
 $V_{F1} < 0.715 \text{ V}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$
 $V_{RRM} = 75 \text{ V}$
 $I_{FSM1} = 2 \text{ A}$
 $t_{rr} < 4 \text{ ns}$

Version 2018-01-25

SOT-363

Dimensions - Maße [mm]

Typical Applications
Signal processing, High-speed
Switching, Rectifying
Commercial grade ¹⁾
Features
Very high switching speed
Low junction capacitance, low I_R
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾
**Mechanical Data ¹⁾**

Taped and reeled

Weight approx.

Case material

Solder & assembly conditions

3000 / 7"

0.01 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL = 1

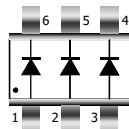
Typische Anwendungen
Signalverarbeitung, Schnelles
Schalten, Gleichrichten
Standardausführung ¹⁾
Besonderheiten
Extrem schnelles Schalten
Niedriges C_j , niedriges I_R
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle

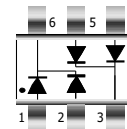
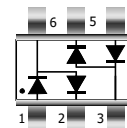
Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

BAS16DW3
Single
DiodesType
Code
KW

1, 2, 3 = A 4, 5, 6 = C

BAV70DW2 x 2
Common
CathodeType
Code
A41 = A1, 2 = A2, 3 = C3/C4
4 = A3, 5 = A4, 6 = C1/C2**MMBD4448SDW**4 in
Bridge
Config.Type
Code
KB1 = A1, 2 = C1, 3 = AC2
4 = A2, 5 = C2, 6 = AC1**Maximum ratings ²⁾****Grenzwerte ²⁾**

Power dissipation (per device) – Verlustleistung (pro Bauteil)	P_{tot}	200 mW ³⁾
Maximum average forward current – Dauergrenzstrom	I_{FAV}	150 mA ³⁾
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	300 mA ³⁾
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	$t_p \leq 1 \text{ s}$ $t_p \leq 1 \mu\text{s}$	I_{FSM} 0.5 A 2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	MMBD4448SDW, BAS16DW BAV70DW	V_{RRM} 75 V 100 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	-55...+150°C

¹ Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book

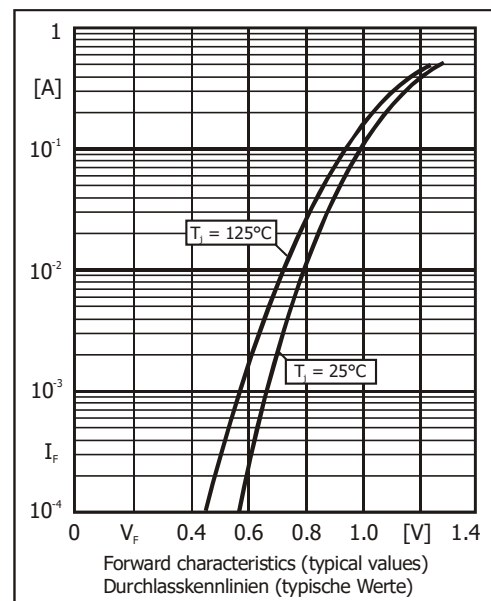
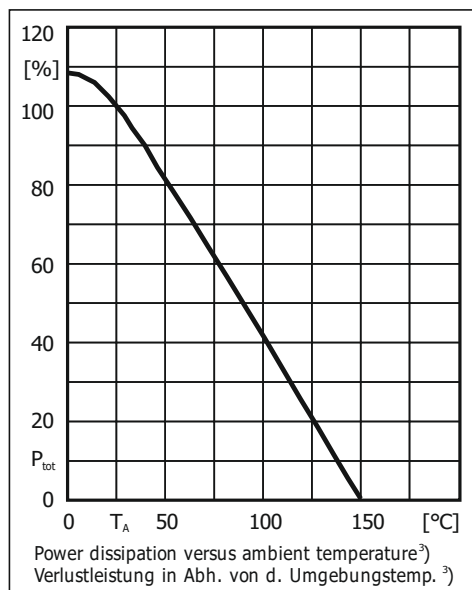
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

² $T_A = 25^\circ\text{C}$ and per diode, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ und pro Diode, wenn nicht anders angegeben

³ Mounted on 3 mm² copper pads per terminal – Montage auf 3 mm² Kupferbelag (Löt pads) je Anschluss

Characteristics
Kennwerte

				BAS16DW	BAV70DW	MMBD4448SDW
Forward voltage Durchlass-Spannung 1)	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F =$	V_F	< 715 mV – < 855 mV < 1.0 V – < 1.25 V	< 715 mV – < 855 mV < 1.0 V – < 1.25 V	– 620 ... 720 mV < 855 mV – < 1.0 V < 1.25 V
Leakage current Sperrstrom 1)	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R =$	I_R	< 30 nA – < 1.0 μA –	– < 30 nA – < 0.5 μA	< 25 nA – – < 100 nA
	$T_j = 150^\circ\text{C}$	$V_R =$	I_R	< 30 μA < 50 μA –	– < 30 μA < 100 μA	< 30 μA < 50 μA –
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		C_T	typ. 2 pF 2)		
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 10\text{ mA}$ über/through $I_R = 10\text{ mA}$ bis/to $I_R = 1\text{ mA}$		t_{rr}	< 4 ns 2)		
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R_{thA}	< 400 K/W 3)		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$
Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Valid per diode – Gültig pro Diode
- 3 Mounted on 3 mm² copper pads per terminal
Montage auf 3 mm² Kupferbelag (Löt pads) je Anschluss